

Dialog SDK 5.x.x 培训教程4-

睡眠模式

2016.5 ...personal ...portable ...connected



睡眠模式概览

扩展睡眠模式

深度睡眠模式

对单个非易失性存储单元进行掉电操作

结论





睡眠模式概览



The DA1458x 有两种睡眠:

- 扩展睡眠模式 (请看下一页PPT框图):
 - ➤ 只有42KB的系统RAM和非易失性RAM仍保持上电状态.
- 深度睡眠模式 (请看下一页PPT框图):
 - ➤ 只有非易失性RAM保持上电状态.

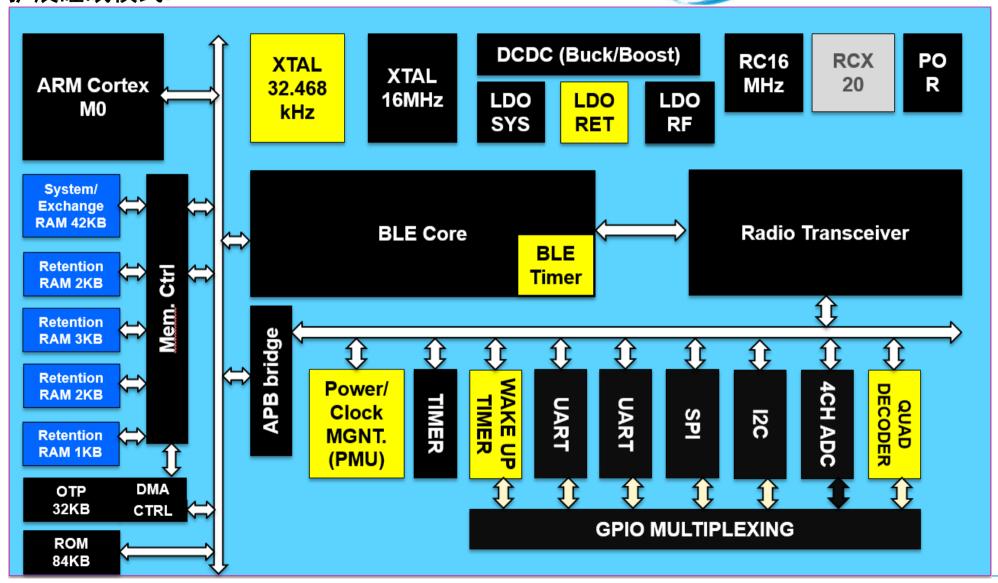
<u>注意:</u> 只有在OTP被烧录程序的状态下,才能检测深度睡眠模式下的电流.

无论选择哪种睡眠模式, DA1458X都可以被以下两种方式唤醒:

- 同步模式, BLE定时器可以被编程用来唤醒系统
- 异步模式,通过外部输入中断来唤醒.

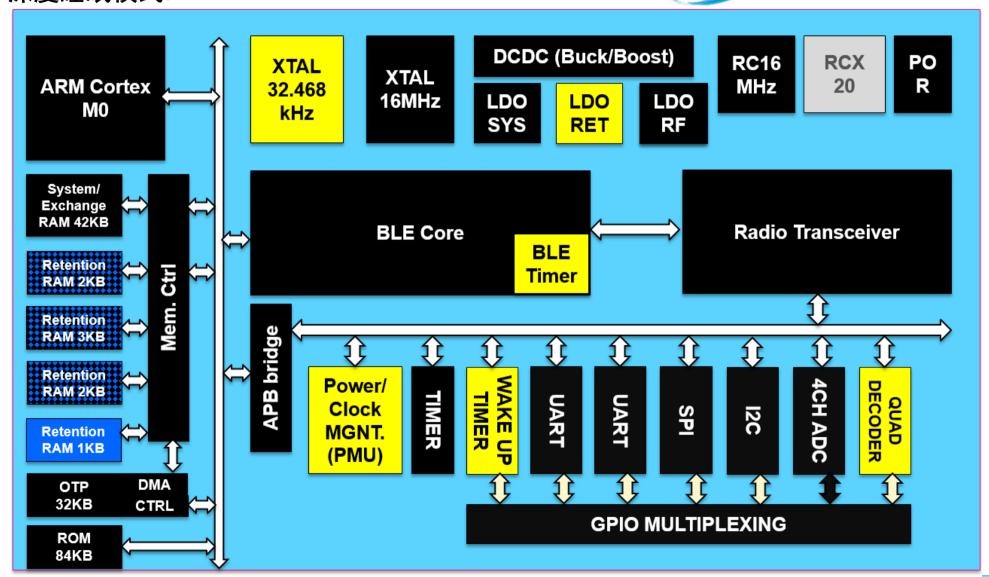


扩展睡眠模式:





深度睡眠模式:





睡眠模式特点:

1) 外部处理器模式(通过GTL接口):

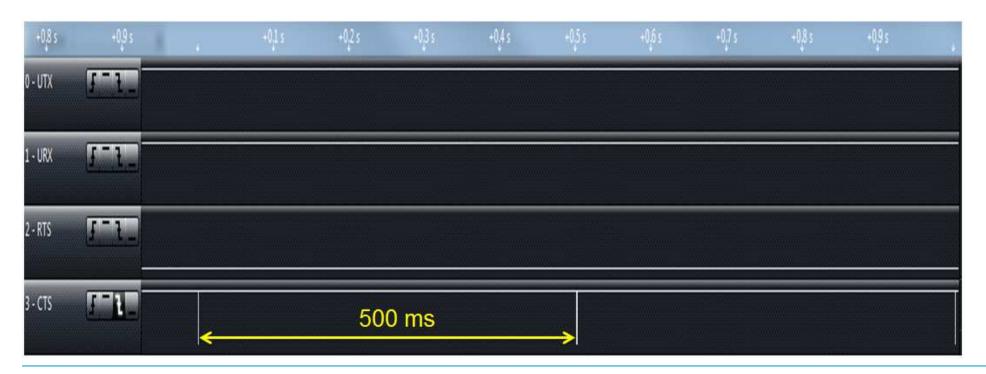
在一段时间内,周期性唤醒去查询GTL接口的流控状态,可以通过如下定义: #define:

#define CFG_MAX_SLEEP_DURATION_PERIODIC_WAKEUP_MS 500 // 500 msec

默认设定500ms用来唤醒。这个时间被认为对UART接口操作是最优的选择。

最长可以设定的时间为23.3小时,因为定时器变量是27bit,所以最长时间为= 2^27 * 0.625ms(BLE 单个心跳持续时间)

最短可以设定的时间为10ms (The DA1458x 需要5.7ms来唤醒),这不是一个比较好的选择,只是用来说明周期性唤醒条件下最短可以设定的时间





睡眠模式特点:

2) 内部处理器模式:

一段用于唤醒DA1458X的周期可以通过以下定义来实现:

#define CFG MAX_SLEEP_DURATION_EXTERNAL_WAKEUP_MS 10000 // 10s

The DA1458x 在没有BLE和定时器事件需要处理的情况下,会在之前提到的时间间隔里面醒来(在我们的例子里面是10S). 最长可以设定的时间为23.3小时。这是因为定时器变量是27bit,所以最长时间为= 2^27 * 0.625ms(BLE 单个心跳持续时间) 最短可以设定的时间为10ms (The DA1458x 需要5.7ms时间来唤醒),这不是一个比较好的选择,只是用来说明周期性唤醒条件下最短可以设定的时间

在进入睡眠前可以关闭这个唤醒功能,只需要调用API接口: app_ble_ext_wakeup_on();

→ 这个会关闭所有的BLE事件和周期性事件

当58x从冬眠模式唤醒后,这个API接口会被调用:app_ble_ext_wakeup_off();

这个流程在Proximity Tag的参考设计里面已经实现,可以参考以下链接:

http://support.dialog-semiconductor.com/connectivity/reference-design/proximity-tag









扩展睡眠模式



设置扩展睡眠模式

TODO 1 - 通过以下链接打开proximty reporter工程:

projects\target_apps\ble_examples\prox_reporter\Keil_5

TODO 2 - 在user config文件夹下打开文件/* @file user config.h */.

TODO 3 - 设定app default sleep mode变量为ARCH EXT SLEEP ON:

const static sleep_state_t app_default_sleep_mode = ARCH_EXT_SLEEP_ON;

TODO 4 - 通过点击Build按钮,编译工程:

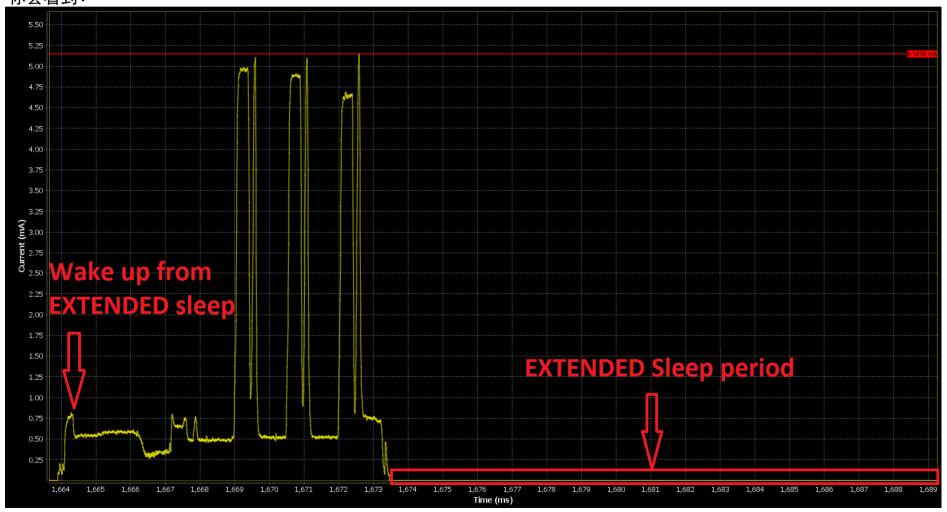


TODO 5 - 将PRO或者BASIC开发板连接PC.



TODO 6 - 打开SmartSnippets工具(可以在如下链接下载到: http://support.dialog-semiconductor.com/

你会看到:





测量扩展睡眠模式

TODO 1 - 在user_config文件下打开文件 /* @file user_config.h */ .

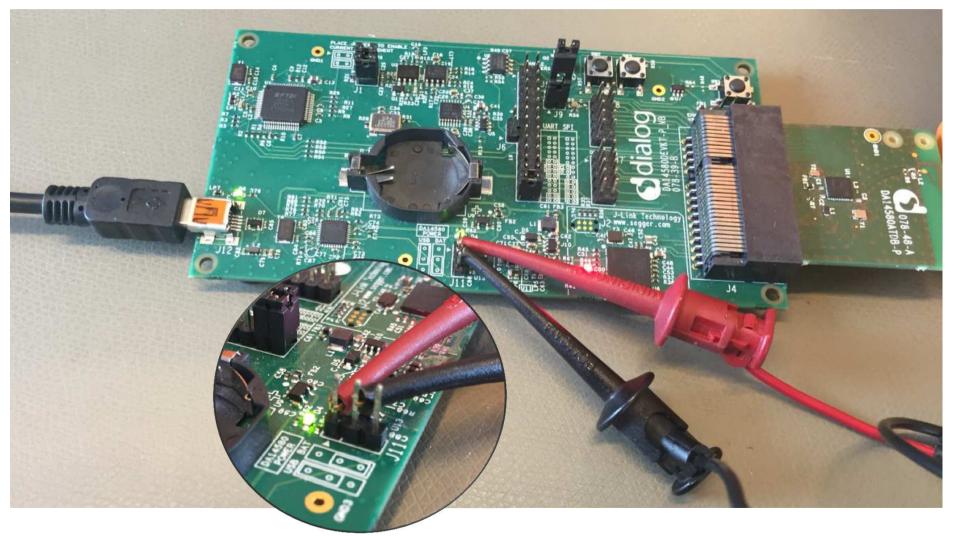
TODO 2 - 修改结构user_undirected_advertise_conf里的变量.intv的值到10000(=6.2 sec),用来设定较大的广播周期. 这样会有足够的时间来测量扩展睡眠条件下的电流.

```
static const struct advertise_configuration user_undirected_advertise_conf = {
    /// Advertise operation type.
    .advertise_operation = ADV_UNDIRECT,
    /// Own BD address source of the device:
    .address_src = GAPM_PUBLIC_ADDR,
    /// Advertise interval
        .intv = 10000, // EXTENDED SLEEP CURRENT = 10000*0.625 = 6.2 sec
    ///Advertising channel map
    .channel_map = 0x7,
};
```

TODO 3 - 重复前页PPT的操作4到6.



TODO 4 - 参照如下图连接安培表用来测量扩展睡眠条件下的电流.





TODO 5 – 测量扩展睡眠模式下的电流. 电流值应该为**1.4 μλ左右**. 在我们的测试里,测量得到1.35 μλ.



不建议通过SmartSnippets工具来检测100uA以下的电流.









设定睡眠模式

```
TODO 1 - 从以下目录打开 proximity reporter工程
         projects\target apps\ble examples\prox reporter\Keil 5
TODO 2 - 在user_config文件夹下打开文件/* @file user_config.h */.
TODO 3 - 设定变量app default sleep mode为ARCH DEEP SLEEP ON
         const static sleep state t app default sleep mode = ARCH DEEP SLEEP ON;
TODO 4 - 在user config文件夹下打开文件/* @file da1458x_config_advanced.h */
TODO 5 - 定义CFG BOOT FROM OTP
TODO 6 - 在user config文件夹下打开文件 /* @file da1458x config basic.h */.
TODO 7 - 取消定义CFG MEM MAP EXT SLEEP 参量
       - 取消定义CFG DEVELOPMENT DEBUG 参量
       - 定义CFG MEM MAP DEEP SLEEP 参量
```



设定深度睡眠模式

TODO 8 - 修改结构user_undirected_advertise_conf里的变量.intv的值到10000(=6.2 sec),用来设定较大的广播周期. 这样会有足够的时间来测量扩展睡眠条件下的电流.

```
static const struct advertise_configuration user_undirected_advertise_conf = {
    /// Advertise operation type.
    .advertise_operation = ADV_UNDIRECT,
    /// Own BD address source of the device:
    .address_src = GAPM_PUBLIC_ADDR,
    /// Advertise interval
        .intv = 10000, // EXTENDED SLEEP CURRENT = 10000*0.625 = 6.2 sec
    ///Advertising channel map
    .channel_map = 0x7,
};
```

TODO 9 - 连接PRO或者BASIC板到PC.

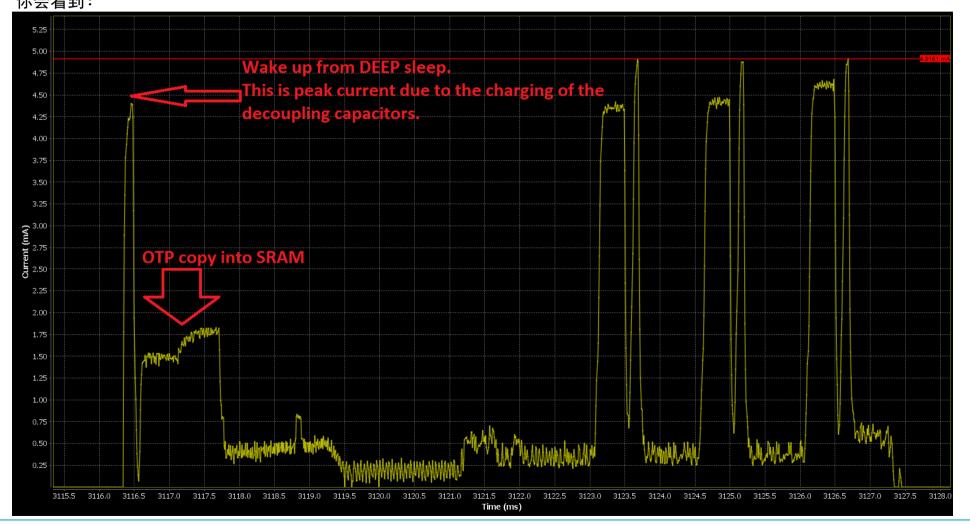
TODO 10 - 用SmartSnippets工具烧录OTP.
可以通过查询用户手册里的帮助信息,来了解如何烧录OTP.





设定深度睡眠模式

TODO 6 - 打开SmartSnippet工具 (可以在链接找到: http://support.dialog-semiconductor.com/ 你会看到:

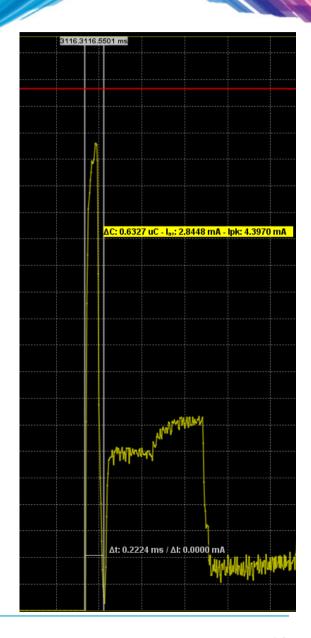




设定深度睡眠模式

测量:

由于充电的电容影响,峰值电流时的电量消耗大概是 0.6 µC

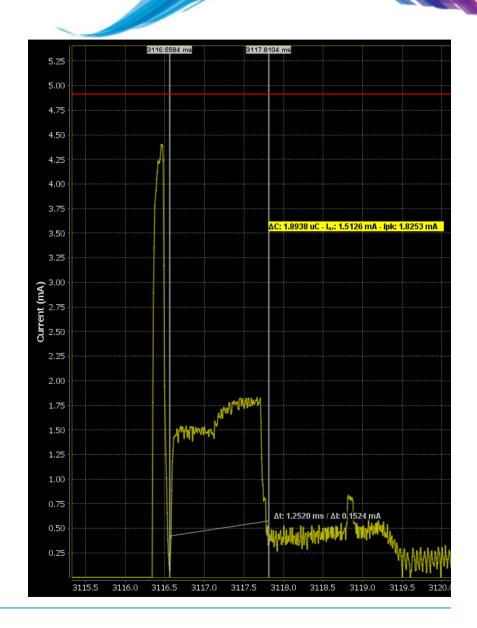




设定深度睡眠模式

测量结果:

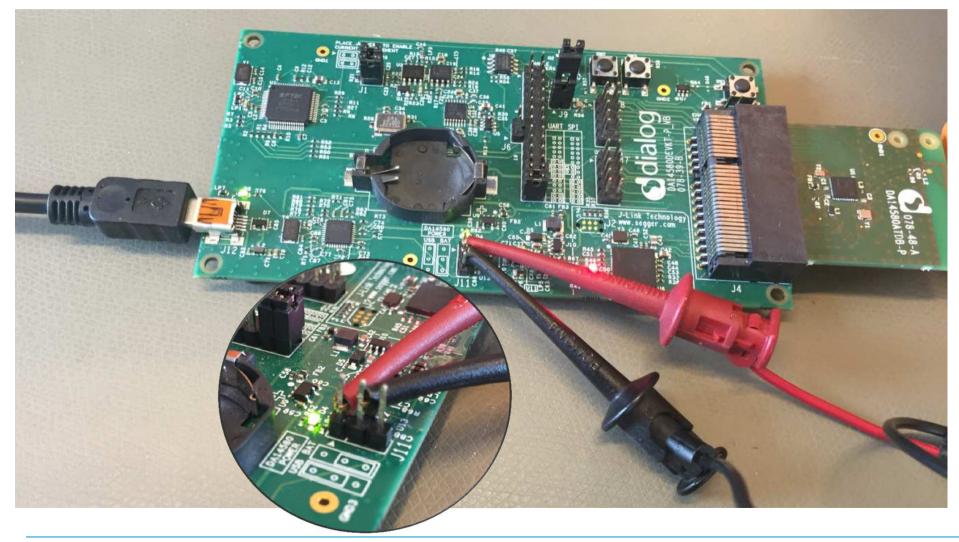
OTP拷贝,约需耗费2µC电量





测量深度睡眠模式

TODO 1 - 连接电流表用于测量深度睡眠模式下的电流.





TODO 5 - 测量深度睡眠模式下的电流.

一般都是 800 nA. 在我们的测试里,结果为810 nA.



不建议通过SmartSnippets工具来检测100uA以下的电流.











对单个非易失性存储单元进行掉电操作只能用于扩展睡眠模式.

```
TODO 1 - 从以下目录打开 proximity reporter工程
         projects\target apps\ble examples\prox reporter\Keil 5
TODO 2 - 找到void SystemInit (void) 函数流程
TODO 3 - 修改SetBits16(PMU CTRL REG, RETENTION MODE, 0xF);
          到SetBits16(PMU CTRL REG, RETENTION MODE, 0x3);
TODO 4 - 找到常量static const struct advertise configuration user undirected advertise conf
TODO 5 - 修改* .intv = 1100, * -----> * .intv = 11000, *
TODO 6 - 修改 sleep_state_t app_default_sleep_mode=ARCH_EXT_SLEEP_ON;
TODO 7 - 编译代码,并下载binary文件到设备.
```



像Agilent 34461A 6 1/2 数字万用表这种精密仪器会被拿来测试电流



结果:

依据如下配置的不同,会省一些功耗:

SetBits16(PMU_CTRL_REG, RETENTION_MODE, 0xF); Extended sleep mode current consumption: 2,037 µA SetBits16(PMU_CTRL_REG, RETENTION_MODE, 0x3); Extended sleep mode current consumption: 1,957 µA 差值大概在80 nA







结论: 扩展和深度两种睡眠之间的差异

	扩展睡眠模式	深度睡眠
内存保持上电状态	系统RAM 42 kB + 8 kB 扩展RAM	8 kB 非易失性RAM
电流消耗 (降压模式, 8 kB 非易失性RAM保持Active 状态,使用外部32KHz晶体)	≈ 1.4 µA	≈ 800 nA
OTP内容是否需要copy?	从扩展睡眠模式下醒来,OTP 内容不需要拷贝到SRAM里面。 (对功耗没有影响)	从深度睡眠模式下醒来,OTP 内容需要拷贝到SRAM里面 (额外功耗: 2.6 μC电量!)

对一般的应用来说,如果广播周期和连接周期小于2s,那么一般推荐扩展睡眠模式.

内部RCX20晶体 (<500 ppm), 只有在降压模式下才能被使用:

- 两种睡眠模式下都会计数
- 在连接状态下,或者不限时间的广播状态下,最多可以记到2s时间



参考文件

- 在Dialog官网注册可以获得更好的开发支持
 - http://support.dialog-semiconductor.com/user/register
 - UM-B-006_DA14580_581 Sleep mode configuration



The Power To Be...



